

55
А-42

ВИЛЬНЮССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ УНИВЕРСИТЕТ
им. В. КАПСУКАСА

Ф. Г. АНИСИМОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
СТРУКТУРЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ПРИМЕСНЫХ
ЦЕНТРОВ В ФЛЮОРИТАХ

(Диссертация написана на русском языке)

01.041 — Теоретическая и математическая физика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

СК

Работа выполнена в Институте физики полупроводников Академии наук Литовской ССР.

Научный руководитель — кандидат физико-математических наук, доцент Р. С. ДАГИС.

Официальные оппоненты: доктор физико-математических наук Н. Н. КРИСТОФЕЛЬ; кандидат физико-математических наук, доцент Э. В. МАУЗА.

Ведущее учреждение — Казанский Государственный Университет им. В. И. Ульянова-Ленина.

Автореферат разослан *24* марта 1972 г.

Защита диссертации состоится *16* мая 1972 г.
на заседании Объединенного ученого Совета Физического и Механико-математического факультетов Вильнюсского Ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В. Капсукаса (Вильнюс, ул. Партизану, 24/17, физическая аудитория № 103).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ВГУ (Вильнюс, ул. Университето, 3).

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 232006, Вильнюс-6,
ул. Партизану, 24/17, физический факультет ВГУ, Ученому секретарю
Совета.

Ученый секретарь ВГУ

ВИЛЬНЮССКИЙ ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. КАПСУКАСА

Ф. Г. АНИСИМОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ПРИМЕННЫХ ЦЕНТРОВ В ФЛЮОРИТАХ

(диссертация написана на русском языке)

01.041 — теоретическая и математическая физика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Вильнюс — 1972

Работа выполнена в Институте физики полупроводников
Академии наук Литовской ССР.

Научный руководитель – кандидат физико-математических
наук, доцент Р.С.ДАГИС.

Официальные оппоненты: доктор физико-математических
наук Н.Н. КРИСТОФЕЛЬ; кандидат физико-математических наук,
доцент Э.В. МАУЗА.

Ведущее учреждение – Казанский Государственный Универ-
ситет им. В.И. Ульянова-Ленина.

Автореферат разослан " " 1972г.

Заплата диссертации состоится " " 1972г.
на заседании Объединенного ученого Совета Физического и
Механико-математического факультетов Вильнюсского Ордена
Трудового Красного Знамени государственного университета
им. В.Капсукаса (Вильнюс, ул.Партизану, 24/17, физическая
аудитория № 103).

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке
ИГУ (Вильнюс, ул.Университето,3).

Отзывы на автореферат направлять по адресу: 232006,
Вильнюс-6, ул.Партизану, 24/17, физический факультет ИГУ,
Ученому секретарю Совета.

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИГУ

Исследование спектров поглощения и люминесценции,
спектров ЭПР и ЯМР, изменения спектров под действием электри-
ческого и магнитного поля, направленного и всестороннего давле-
ния привело к накоплению большого экспериментального материа-
ла об энергетических спектрах ионных кристаллов, активирован-
ных редкоземельными ионами. При интерпретации эксперименталь-
ных данных предпочтение обычно отдается разным полуэмпириче-
ским методам (теории кристаллического поля, методу углового
перекрывания, методу Вольфсберга – Гельмгольца и его разным
модификациям), пользуясь которыми результаты можно получить
не совершая сложных вычислений. Однако, как правило, при
построении полуэмпирических методов приходится пользоваться
разными предположениями, действительность которых и тем са-
мым область применимости самого метода может быть установле-
на только после проведения последовательных теоретических
исследований.

Основной задачей, которая ставилась в диссертации и
было проведение таких исследований в случае редкоземельных
примесных центров в ионных кристаллах. Чтобы излишне не
сложнять задачу рассматривались сравнительно простые систе-
мы – Tb^{2+} , Yb^{3+} в флюоритах. Главное внимание уделялось
исследованию расщеплений уровней 4f-электронов в кристал-
лическом поле и расчету g-факторов для экспериментально
довольно хорошо изученных случаев $CaF_2:Tb^{2+}$ и $SrF_2:Tb^{2+}$.

Рассмотрение двух параллельных случаев с одной стороны способствует проверке расчетов, а с другой стороны позволяет получить некоторую информацию о роли возможных искажений решетки, обусловленных различием ионных радиусов примесного и замещаемого иона. Расчеты проведены в приближении комплекса $(\text{TiF}_8)^{6-}$ в поле остатка кристалла V_{kp} . Сферическая составляющая V_{kp} , которая предполагается постоянной в области комплекса непосредственной роли в расчетах не играет (она обеспечивает устойчивость комплекса), а кубическая учитывается в приближении точечных ионов. Расчет комплекса проводится методом Гейтлера - Лондона. В качестве базиса функций использованы одноэлектронные функции свободных ионов Ti^{2+} и F^- (численные функции Хартри - Фока для Ti^{2+} и аналитические для F^-). Так как в случае открытых оболочек существует несколько равноправных форм уравнений Хартри - Фока (даже в рамках ограниченного метода Хартри - Фока), то для $\text{SrF}_2:\text{Ti}^{2+}$ были проведены расчеты с разными функциями для электронов Ti^{2+} : с функциями типа "а", которые являются решениями уравнений Хартри - Фока, полученных на базисе однодетерминантной волновой функции, в которых в гамильтониане Фока (если не делать предварительно усреднения по угловым переменным) отброшены члены неинвариантные относительно операций группы вращения и функции типа "б", которые являются решениями обычных уравнений Хартри - Фока для центра тяжести конфигурации. В расчетах $\text{CaF}_2:\text{Ti}^{2+}$ были использованы только функции типа "а".

Диссертация состоит из 12 разделов, первый из которых является введением.

Во втором разделе исследуется, как вычисления одноэлектронные функции Хартри - Фока описывают свойства свободного иона Ti^{2+} . Для этого проведен расчет спин-орбитального расщепления терма ^2F основной конфигурации $4f^{13}$ иона Ti^{2+} как с функциями типа "а" так и "б". (Спин-орбитальное взаимодействие рассчитывалось как среднее от оператора Брейта).

В третьем разделе расщепление уровней конфигурации $4f^{13}$ иона Ti^{2+} в CaF_2 и SrF_2 рассмотрено в приближении кристаллического поля.

Четвертый раздел посвящен определению параметров, характеризующих расположение электронных уровней, из экспериментальных данных. В качестве таких параметров выбраны интервалы энергии $\Delta E_{12}=E(K_1)-E(K_2)$ и $\Delta E_{13}=E(K_1)-E(K_3)$ между уровнями, соответствующими электронным кристаллическим конфигурациям K_i ($K_1=A_{2u}^2 t_{2u}^6 t_{1u}^5 T_1$, $K_2=A_{2u}^2 t_{2u}^5 t_{1u}^6 T_2$ и $K_3=A_{2u}^2 t_{2u}^6 t_{1u}^6 A_2$) и постоянные спин-орбитальной связи $\gamma_{AA'}$ ($A, A'=A_{2u}, t_{2u}, t_{1u}$). Получены выражения для уровней энергии через эти параметры диагонализируя одновременно матрицы операторов спин-орбитального взаимодействия и потенциала кристаллического поля в пространстве функций соответствующих конфигураций K_i . Исследовано, как влияет на определение значения параметров ΔE_{12} и ΔE_{13} (а также параметров кристаллического поля) наложение обычно используемого условия, что все $\gamma_{AA'}$ равны.

Расчет комплекса $(\text{TiF}_8)^{6-}$ методом Гейтлера - Лондона проводится в разделах 5-9. В качестве исходного приближения рассматривалась ионная структура $\text{Ti}^{2+}\text{F}_8^-$ (все ионы в основном состоянии), а потом учитывалось наложение конфигураций. Рассмотрено два типа налагаемых конфигураций: а) конфигурации соответствующие структуре $\text{Ti}^{2+}\text{F}_8^-$, но учитывающие возбуждение ионов и б) конфигурации с переносом заряда от лигандов к центральному иону.

Чтобы выяснить роль разных приближений, которые обычно делаются при проведении подобного рода исследований, расчет уровней энергии в рамках структуры $\text{Ti}^{2+}\text{F}_8^-$ проводился весьма последовательно. В пятом разделе рассмотрено как влияет на значения расщеплений учет распределения электронной плотности лигандов (были вычислены поправка Клейнера и соответствующая поправка обусловленная обменным взаимодействием электронов Ti^{2+} и F^-), а также неортогональность $4f$ -функций и функций лигандов. В шестом разделе исследуется роль перекрывающихся лиганд-лиганд, а в седьмом - перекрывания $5s^25p^6$ -лиганд.

В восьмом разделе рассмотрено, как влияет на расположение электронных уровней наложение конфигураций, соответствующих структуре $\text{Ti}^{2+}\text{F}_8^-$, но учитывающих возбуждение ионов. Исследование таких конфигураций связано с выяснением роли так называемого экранирования кристаллического поля для $4f$ -электронов. Рассмотрено как вопрос об экранировании решается в рамках комплекса. Указаны недостатки существующей

теории экранирования. В случае $\text{CaF}_2:\text{Ti}^{2+}$ вычислены поправки к уровням энергии, обусловленные учетом возбуждения $5p \rightarrow 4f$. Значения этих поправок сравнены с соответствующими, полученными предполагая, что поляризация внутренних оболочек обусловлена полем точечных лигандов.

В девятом разделе в случаях $\text{CaF}_2:\text{Ti}^{2+}$ и $\text{SrF}_2:\text{Ti}^{2+}$ проведен расчет поправок к уровням энергии обусловленных смешиванием конфигураций в которых кратность ионизации ионов отличается от исходной, а также соответствующих коэффициентов смешивания (параметров ковалентности). Рассмотрены налагаемые конфигурации, в которых по сравнению с начальной электрон из молекулярной орбиталы $\chi_{A\alpha}$ лигандов ($A=a_{2u}, t_{2u}, t_{1u}$; $\alpha=2s, 2p\sigma, 2p\pi$) переносится в пустую внешнюю орбиталь A конфигурации K_i . При проведении расчетов предполагалось, что в налагаемых конфигурациях атомные одноэлектронные функции являются теми же самыми, как и в начальной. Показано, что такой подход к учету ковалентности в нами рассмотренных случаях эквивалентен подходу, используемому в обычном методе МО ЛКАО при условии, что при построении молекулярных орбиталей учитываются только $4f$ -функции редкоземельного иона и функции лигандов.

Чтобы показать, как меняется относительная роль ковалентности при переходе от двухзарядных примесных ионов к трехзарядным в разделе 10 приводятся результаты расчета параметров ковалентности для $\text{CaF}_2:\text{Yb}^{3+}$.

В одиннадцатом разделе исследовались g -факторы как основного состояния Γ_7 в $\text{CaF}_2:\text{Ti}^{2+}$, $\text{SrF}_2:\text{Ti}^{2+}$, так и возбужденного Γ'_7 . Расчеты проводились как в приближении кристаллического поля, так и в приближении комплекса. Получены выражения для ковалентных множителей уменьшения орбитального момента через параметры ковалентности, групповые интегралы перекрывания и радиальные интегралы.

В двенадцатом разделе приводятся основные результаты диссертационной работы, которые можно резюмировать следующим образом:

1. Пользуясь численными функциями Хартри - Фока вычисленное значение постоянной спин-орбитального взаимодействия ζ_{4f} для свободного иона Ti^{2+} (несмотря на сравнительно большой заряд ядра) довольно хорошо согласуется с экспериментальным. (Отклонение составляет несколько процентов от общей величины постоянной). Значения ζ_{4f} , полученные при помощи функций типа "а" и функций типа "б", отличаются незначительно (расхождение составляет 1% общей величины расщепления). Незначительно отличаются также и значения параметров Слэтера, полученные при помощи "а" и "б" типа функций.

2. Показано, что теоретические значения параметров кристаллического поля, вычисленные в приближении точечных лигандов, весьма неоднозначные. Например, значение параметра b_6 для $\text{Ti}^{2+}:\text{SrF}_2$, вычисленное при помощи $4f$ -функций типа "а" почти в два раза больше, чем соответствующее

значение, полученное при помощи функций типа "б".

3. Из сравнения значений постоянной спин-орбитально-го взаимодействия для свободного иона и иона в кристалле, а также из анализа выражений для собственных значений матрицы энергии следует, что весьма корректно из экспериментальных данных можно определить только величину расщепления ΔE_{13} . Величина второго интервала ΔE_{12} сильно зависит от величины разности между разными $\zeta_{AA'}$, которую из экспериментальных данных непосредственно определить нельзя. Неоднозначность при определении ΔE_{12} сильнее сказывается на величине параметра b_6 , чем b_4 , поэтому экспериментальное значение параметра b_4 более корректное, чем в b_6 .

4. Учет распределения электронной плотности лигандов (учет поправки Клейнера и соответствующей поправки из-за обменного взаимодействия между $4f$ -электронами и электронами лигандов), как и в случае ионов группы железа, обращает знак параметров кристаллического поля (по сравнению со значениями, полученными в приближении кристаллического поля).

5. Расчеты расщепления в рамках одной ионной структуры $\text{Ti}^{2+}\text{F}_6^-$ (без учета внутриионной корреляции) показали, что хотя основной вклад в расщепление вносит перекрывание $4f$ -лиганд, поправка из-за учета перекрывания лиганд-лиганд весьма существенная. Учет перекрывания $5s^25p^6$ -лиганд сравнительно мало влияет на величину ΔE_{13} . В таком приближении вычисленное значение ΔE_{13} составляет 709cm^{-1} .

для Ti^{2+} в CaF_2 и 489 см^{-1} (функции типа "а"), 352 см^{-1} (функции типа "б") для Ti^{2+} в SrF_2 . (Соответствующие экспериментальные значения 966 см^{-1} и 830 см^{-1}).

6. Показано, что в рамках комплекса вопрос об экранировании кристаллического поля для $4f$ -электрона решается довольно просто и сводится к рассмотрению поправок к уровням энергии, обусловленных наложением конфигураций, в которых электрон из замкнутой оболочки центрального иона возбуждается в вакантную орбиталь. Рассмотрение конкретного примера (соответствующего учету $5p \rightarrow 4f$ возбуждения в обычной теории экранирования) показало, что поправки, получаемые в рамках точечной модели лигандов и в приближении комплекса отличаются почти в 10 раз. Однако из приведенных расчетов для Ti^{2+} в CaF_2 следует, что учет смещивания такой конфигурации изменяет ΔE_{13} очень незначительно (9 см^{-1}).

7. Показано, что поправки к ΔE_{13} из-за учета наложения структур типа $Ti^{2+}F_7^-F$ (ковалентности) сравнительно невелики (для Ti^{2+} в CaF_2 — 95 см^{-1}), т.е. исходное приближение $Ti^{2+}F_8^{2+}$ является достаточно хорошим. Из расчетов, проведенных для Ti^{2+} в SrF_2 с функциями типа "а" и "б" (соответствующие поправки к ΔE_{13} равны соответственно 52 см^{-1} и 53 см^{-1}), следует, что приближение структуры $Ti^{2+}F_8^{2+}$ становится более хорошим (относительная роль ковалентности уменьшается), если пользоваться более протяженными $4f$ -функциями (функциями типа "а").

8. Вычисления при помощи функций типа "а" с учетом наложения структур значений расщепления ΔE_{13} сравнительно неплохо согласуются с экспериментальными: $\Delta E_{13}^{\text{теор}} = 804 \text{ см}^{-1}$ для Ti^{2+} в CaF_2 и 541 см^{-1} для Ti^{2+} в SrF_2 . (Соответствующие экспериментальные значения 966 см^{-1} и 830 см^{-1}). Худшее совпадение для SrF_2 следует объяснить тем, что в расчетах использовались расстояния соответствующие идеальным кристаллам SrF_2 и CaF_2 . Так как радиус иона Ti^{2+} несколько больше, чем Ca^{2+} и меньше, чем Sr^{2+} , то из-за возможного искажения решетки величина ΔE_{13} для CaF_2 является несколько преувеличеною, а для SrF_2 — уменьшеною.

9. На примере кубического центра Yb^{3+} в CaF_2 показано, что относительная роль ковалентности сильно возрастает при переходе от двухзарядных редкоземельных примесных ионов в MeF_2 к трехзарядным. Если для двухзарядных ионов (при формальном разделении вкладов ковалентности и неортогональности), доминирующую роль играет неортогональность, то для трехзарядных ситуация получается обратной: параметры ковалентности $Y_{A\alpha}$ (для $2p$ -функций) по своей величине больше соответствующих групповых интегралов перекрывания.

10. Из расчетов g -факторов g_F и $g_{F'}$ для Ti^{2+} в CaF_2 и SrF_2 следует, что учет неортогональности функций электронов примесного иона и лигандов и ковалентности улучшает согласие вычисленных значений с экспериментальными. Отклонение вычисленных в приближении комплекса $(TiF_8)^{6-}$ значений от

экспериментальных $\Delta Q_r = Q_r^{\text{эксп}} - Q_r^{\text{теор}}$ составляет $\Delta Q_r = -0,020$,
 $\Delta Q_r = 0,020$ для $\text{CaF}_2:\text{Tu}^{2+}$ и $\Delta Q_r = -0,024$,
 $\Delta Q_r = 0,020$ для $\text{SrF}_2:\text{Tu}^{2+}$. Эти отклонения коррелируют с
соответствующим отклонением для ΔE_{43} . Улучшения согласия с
экспериментом можно достичнуть пользуясь более растяженными
радиальными $4f$ -функциями. К тому же выводу приводит и срав-
нение вычисленных и экспериментальных значений постоянной
спин-орбитального взаимодействия.

Материалы диссертационной работы доложены на следующих
конференциях:

1. III Всесоюзное совещание по применению новейших
физических методов к исследованию координационных соедине-
ний, г.Кишинев, 29 октября - 2 ноября 1968 г.;

2. Международный симпозиум по теории электронных
оболочек атомов и молекул, г.Вильнюс, 16-20 июня 1969 г.;

3. III симпозиум по спектроскопии кристаллов, активиро-
ванных ионами редкоземельных и переходных металлов, г.Ленин-
град, 4-10 мая 1970 г.;

4. Семинар "Избранные проблемы теории примесного центра
кристалла", г.Таллин, 21 - 26 сентября 1970г;

5. XLI Всесоюзный съезд по спектроскопии, г.Минск,
5-9 июля 1971г.

Основные результаты диссертации отражены в тезисах
перечисленных конференций и опубликованы в работах:

1. АНИСИМОВ Ф., ДАГИС Р. Влияние распределения зарядов
 $\text{CaF}_2:\text{RE}^{2+}$ лигандов на параметры кристаллического поля в случае $\text{CaF}_2:\text{Tu}^{2+}$.
"Литовский физический сборник", т.9, 1969, № 5, с.881-888, с табл. -
Резюме на литов. и англ. яз. - Библиогр.: 12 назв.
2. АНИСИМОВ Ф. и ДАГИС Р. Влияние электронной структуры
лигандов на параметры кристаллического поля в случае $\text{CaF}_2:\text{Tu}^{2+}$.
"Оптика и спектроскопия", т.29, 1970, вып. I, с.209-210,
с табл. - Библиогр.: 7 назв.
3. АНИСИМОВ Ф., ДАГИС Р. Влияние неортогональности
 $4f$ -функций Tu^{2+} и функций лигандов на параметры кристалличес-
кого поля в случае $\text{Tu}^{2+}:\text{CaF}_2$. - "Литовский физический сборник",
т.II, 1971, № 2, с.211-222, с табл. - Резюме на литов. и англ.
яз. - Библиогр.: 14 назв.
4. АНИСИМОВ Ф., ФЕСЕНКО Н., ДАГИС Р. Влияние перекрывания
функций электронов заполненных оболочек на параметры кристалли-
ческого поля в $\text{Tu}^{2+}:\text{CaF}_2$. - "Литовский физический сборник",
т.II, № 3, с.421-423, с табл., - Резюме на литов. и англ.яз.-
Библиогр.: 6 назв.
5. АНИСИМОВ Ф., ДАГИС Р. Влияние ковалентности на расщепле-
ние уровней Tu^{2+} в CaF_2 . - "Литовский физический сборник", т.II,
1971, № 3, с.425-431, с табл. - Резюме на литов. и англ.яз.-
Библиогр.: 4 назв.
6. ВАЛЯ А., АНИСИМОВ Ф., ДАГИС Р. Изучение кристалли-
ческого поля для $4f$ -оболочки редкоземельных ионов. - "Литов-
ский физический сборник", т.12, 1972, № 1, с.5-71, - Резюме
на литов. и англ. яз. - Библиогр.: 10 назв.

7. ANISIMOV F., RAKAUSKAS R., and DAGYS R. Crystal Field in CaF_2 : Tm III.- "Physica status solidi", vol.35, 1969, No.1, p. K75-K76. - Bibliogr. : 5.
8. ANISIMOV F. and DAGYS R. Overlap and Covalent Contributions to the Crystal Field Splittings in CaF_2 : Tm^{2+} .- "Physica status solidi (b)", vol.44, 1971, No.2, p.821-827, il. - Bibliogr. : 12.
9. ANISIMOV F., VALA A., and DAGYS R. The Shielding of Crystal Field at Tm^{2+} in CaF_2 - "Physica status solidi (a)", vol.6, 1971, No.1, p. K15-K17. - Bibliogr. : 5.

